

# Procedimiento de fabricación de dispositivos optoelectrónicos de banda intermedia basados en tecnología de lámina delgada

## Información de contacto

### Dirección: Principales:

- ANTONIO MARTI VEGA

**antonio.marti@upm.es**

- DAVID FUERTES MARRON

**david.fuertes@upm.es**

- ANTONIO LUQUE LOPEZ

**a.luque@upm.es**

## Tipo de oferta tecnológica

Patentes

## ¿Dónde?

Instituto de Energía Solar (IES) Silicio y Nuevos Conceptos para Células Solares

## Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=161&id\\_archivo=127&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

## Descripción de la patente

Procedimiento de fabricación de dispositivos optoelectrónicos de banda intermedia basados en tecnología de lámina delgada caracterizado porque comprende, al menos, las siguientes etapas:

- una primera etapa, donde sobre un substrato (1) se deposita una capa metálica (2) que actuará como electrodo;
- una segunda etapa, donde sobre la capa metálica (2) se deposita un elemento semiconductor de tipo p (3); y
- una tercera etapa, de procesado del material de banda intermedia;

donde dicho material de banda intermedia consiste en un estructuras nanoscópicas (4) de material multinario de tipo (Cu, Ag)(Al, Ga, In)(S, Se, Te)<sub>2</sub> embebido en una matriz (5) de composición similar, salvo por la ausencia de, al menos, un catión presente en la estructura nanoscópica.

## Situación

Concedida

## Número de solicitud

P200801711

## Número de publicación

ES2311431

**Fecha de presentación**

06/06/2008

**Fecha de concesión**

07/07/2009